Лекция 1. Часть 2. Обзор процессов, происходящих в твердом теле при его бомбардировке заряженными частицами

2.1. Процессы, происходящие в веществе при его бомбардировке электронами.

1. Понятия:

- упругие и неупругие взаимодействия;
- торможение;
- рассеяние;
- термализация.

- 2. Упругие взаимодействия с атомами облучаемого вещества:
 - образование радиационных дефектов (Е > нескольких сотен кэВ);
 - фононные колебания (на дискретных квантовых частотах);
 - упругое отражение электронов.

3. Неупругие взаимодействия:

- генерация излучений (становится существенным при достаточно высоких энергиях ускоренных электронов (E_{порог} зависит от свойств мишени и превышает для многих веществ 10 МэВ):
 - тормозного;
 - переходного;
 - черенковского;
- когерентного испускания рентгеновских квантов (в каналах монокристаллов);

- электрон-электронные взаимодействия (это основной тип взаимодействий, при которых теряется энергия ускоренных электронов с энергией менее 10 МэВ):
- <u>коллективные:</u> плазмоны кванты колебаний плотности системы валентных электронов при ее возбуждении ускоренным электроном;

^{*} плазменные колебания имеют дискретные квантовые частоты;

^{*} при распаде плазмонов выделяется энергия, которая затем уносится в виде э/м излучения или передается подходящему электрону твердого тела;

^{*} плазменные колебания возбуждаются, если длина их волн много больше расстояния между свободными электронами, т.е. их энергия невелика;

^{*} рассеяние электрона при возбуждении плазмона происходит на небольшой угол, т.к. от электрона передается небольшое количество импульса и энергии;

- <u>одночастичные:</u> ускоренный электрон взаимодействует с индивидуальным электроном;

- * передается большая доля энергии первичного электрона, рассеяние ускоренного электрона происходи на большие углы;
- * энергия первичного электрона тратится на возбуждение и ионизацию атомов, а также передается электронам проводимости;

схема возбуждения и ионизации: электрон на внутренней оболочке получает энергию, достаточную для перехода на вышележащие энергетические уровни -> переход на вышележащие энергетические уровни -> возбуждение и ионизация.

4. Отражение электронов

- упругое отражение первичных электронов;
- неупругое отражение первичных электронов;
- эмиссия вторичных электронов с облучаемой поверхности.

5. Процессы, происходящие при снятии возбуждения атомов:

- оже-процессы (безызлучательная передача дискретной порции энергии оже-электрону при переходе электронов из вышележащих энергетических уровней на вакансии на более низких оболочках);
- характеристическое излучение (при заполнении вакансий на внутренних электронных оболочках испускается квант э/м излучения, величина которого характерна для данного вещества и данных оболочек, спектр излучения в области рентгеновских длин волн).

- 6. Методы анализа поверхности с использованием электронного облучения:
 - вторичная электронная спектроскопия;
 - оже-спектроскопия;
 - рентгеноспектральный анализ.
- 7. Изменение проводимости полупроводников и диэлектриков (радиационная проводимость).
- 8. Когда атом в возбужденном состоянии, то его связи с соседями могут меняться; это приводит к:
 - десорбции чужеродных атомов (радиационно-стимулированная десорбция);
 - диссоциации химических соединений;
 - образованию химических соединений;
 - образованию радиационных дефектов внутри кристаллов.

- 9. Диссипация энергии ускоренных электронов при их взаимодействии с веществом:
 - унос энергии с поверхности электронами, фотонами, атомными частицами (некоторая доля);
 - превращение в конечном итоге в тепловую энергию облучаемого вещества (большая доля); из зоны торможения тепловая энергия распространяется:
 - путем теплопроводности в глубь вещества;
 - возникновение теплового излучения.

10. Явления, к которым приводит нагрев:

- структурно-фазовые изменения в облучаемом материале;
- усиление диффузии;
- отжиг дефектов;
- плавление, рекристаллизация;
- испарение;
- десорбция, термоэлектронная эмиссия;
- возникновение термоупругих и термопластических напряжений; нарушение сплошности среды и т.д.

- 1. Процессы, которые могут происходить при приближении ионов к бомбардируемой поверхности:
 - потенциальная электронно-ионная эмиссия (ожепроцессы при переходе электронов твердого тела с вышележащих уровней на нижележащие уровни бомбардирующего иона);
 - химические реакции на поверхности в результате возбуждения электронных состояний атомов и молекул, возбуждение свободных химических связей, разрушение адсорбированных соединений.

2. Процессы, происходящие внутри твердого тела:

потеря энергии и рассеяние из-за:

- 1) упругих и неупругих взаимодействий с электронами вещества;
- 2) упругих и неупругих взаимодействий с ядрами атомов вещества;
- 3) излучения различных видов.

- 3. Основные виды потерь энергии ускоренных ионов при энергиях до нескольких МэВ:
 - упругие соударения с ядрами;
 - неупругие соударения с электронами.
- 4. Свойства упругих соударений с ядрами:
 - передача энергии имеет дискретный характер, так как массы взаимодействующих частиц сопоставимы;
 - рассеяние может быть очень существенным.
- 5. Свойства неупругих соударений с электронами вещества:
 - при каждом соударении передается относительно малая доля энергии;
 - рассеяние не слишком велико.

- 6. Явления, основанные на упругом взаимодействии с атомами вещества:
 - отражение бомбардирующих ионов от поверхности;
 - образование радиационных дефектов (приводит к радиационно-стимулированной диффузии,

радиационно-стимулированному отжигу дефектов; изменению химической структуры соединений и химическим реакциям);

- распыление;
- фото-ионная эмиссия (атомы, группы атомов и ионы, вылетевшие в возбужденном состоянии в вакуум, могут переходить в невозбужденное состояние, испуская кванты света).

7. Неупругие взаимодействия с электронной подсистемой вещества приводят к возбуждению электронов и ионизации атомов:

возбуждение электронов – появление электронов на высоких, ранее свободных энергетических уровнях и одновременно образование электронных вакансий на заполненных в условиях термодинамического равновесия более низких уровнях.

- 8. Явления, к которым приводят неупругие взаимодействия с электронной подсистемой:
 - увеличение проводимости у полупроводников и диэлектриков (радиационная проводимость);
 - эмиссия электронов, или кинетическая ионно-электронная эмиссия;
 - оже-процессы;
 - ионолюминесценция, характеристическое рентгеновское излучение;
 - изменение зарядового состояния примесных атомов, дефектов кристаллической решетки и собственных атомов твердого тела, что приводит к изменению энергии активации ряда процессов, в т.ч. диффузии примесей или дефектов, скорости распада сложных дефектов, образованию радиационных дефектов, инициации химических реакций, невозможных в равновесных условиях при данной температуре;

- 9. Почти вся энергия, внесенная ускоренными ионами в вещество и растраченная в упругих и неупругих взаимодействиях, превращается в тепловую. Исключение составляет небольшая доля энергии (как правило, менее 10%), унесенная эмиттированными частицами).
- 10. Нагрев образца и все последующие процессы, которые могут возникнуть при достаточной мощности (плавление, испарение, термоэмиссия электронов, тепловое излучение и т.д.) в общем, ничем не отличаются от подобных процессов, происходящих при бомбардировке вещества электронами.

- 11. Ионное легирование, или имплантация результат внедрения ускоренных ионов в вещество и потери там их начальной энергии во всевозможных упругих и неупругих взаимодействиях.
- 12. Каналирование (имеет место, когда ускоренный ион взаимодействует с монокристаллом; ионы при движении в определенных направлениях «чувствуют» не отдельные атомы, а плоскости или цепочки атомов как целые, поэтому близкие взаимодействия каналируемых ионов с атомами, находящимися в узлах кристаллической решетки, оказываются невозможными).

13. Переходное и тормозное излучение тоже могут иметь место, но они имеют заметную интенсивность только при больших скоростях заряженных частиц, т.е. при энергиях, значительно больших, чем в случае электронной бомбардировки, т.к. массы ионов на несколько порядков больше массы электронов.

- 14. Методы диагностики, основанные на облучении вещества ускоренными ионами:
- метод ионно-нейтрализационной спектроскопии (основан на явлении потенциальной электронно-ионной эмиссии);
- метод обратного рассеяния медленных и быстрых ионов (энергия иона, рассеянного на заданный угол в парном столкновении, если его масса меньше рассеивающего центра, однозначно определяется массами частиц и их начальными энергиями);
- вторичная ионная масс-спектрометрия (основан на распылении);
- ионная оже-спектроскопия (исследуются спектры ожеэлектронов);
- рентгеновская спектроскопия (исследуется характеристическое рентгеновское излучение).